

SiC Planer Power MOSのSCM分析

SiC デバイスの拡散層構造を可視化できます

測定法 : SCM・研磨

製品分野 : パワーデバイス

分析目的 : 形状評価

概要

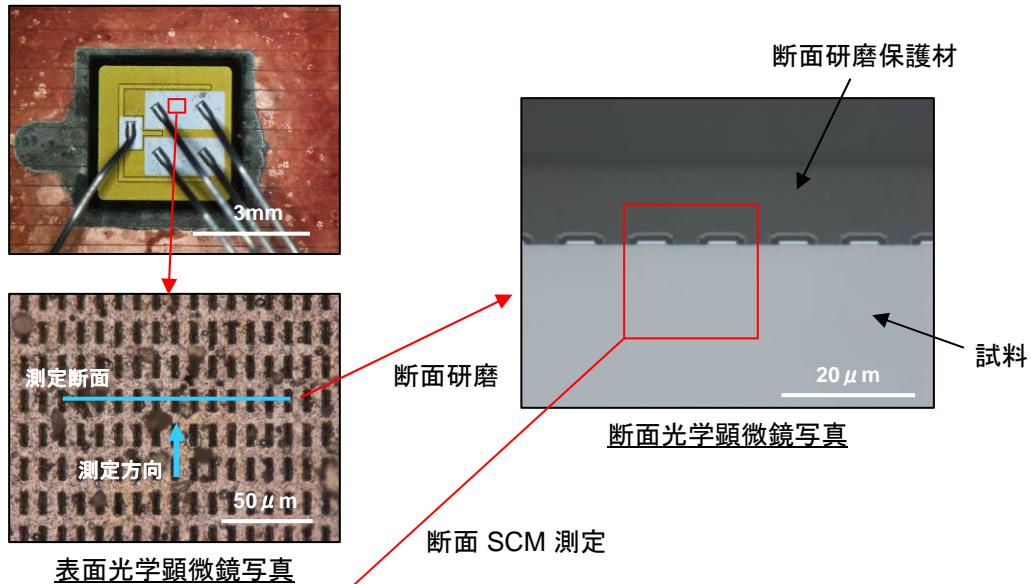
SCM では半導体の p/n 極性を識別し、拡散層の形状を可視化することができます。

本手法は Si デバイスに活用されてきましたが、SiC デバイスにおいてもキャリア濃度が十分高い箇所では評価を行うことができます。

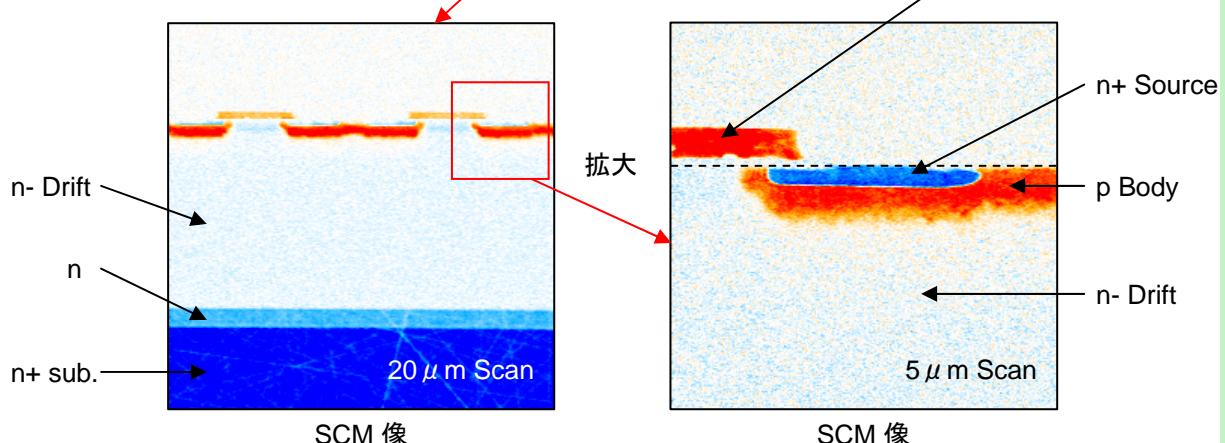
本資料では、SiC Planer Power MOS の断面を製作し、SCM 分析を行った結果をご紹介します。

データ

■測定箇所



■測定データ



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人

MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
URL : <http://www.mst.or.jp/>